



宽带隙半导体技术国家重点学科实验室

首页 | 实验室概况 | 科研团队 | 科学研究 | 仪器设备 | 合作交流 | 最新消息 | 通知公告 |

科学研究

科研奖项

授权专利

论文著作

研究成果



您现在的位置: 首页 >> 科学研究 >> 论文著作 >> 科研论文(杂志和国际会议)-2005年

科研论文(杂志和国际会议)-2005年

1. Efficient Parametric Yield Estimation of VLSI Circuit by Uniform Design Sampling Method
Journal of Microelectronics Reliability. Vol 45/1 pp:155-162, 2005. Jing Ming-e, Hao Yue, Zhang Jin-feng, Ma Pei-jun
2. Strain Property Studies of GaN:Mg Films Grown by MOCVD
Journal Materials Science. Forum Vols. 475-479, p:1697, Jan 2005. Feng Qian, Hao Yue
3. Hot-carrier degradation characteristics and explanation in 0.25 μ m PMOSFETs
Chinese Physics. 2005 14(8)pp:1644-1648, Liu Hong-Xia, Hao Yue, Hawkins I. D. and Peaker A. R..
4. Photoluminescence characteristics of GaN:Si
Chinese Physics. 2005 14(10)pp:2133-2136, Feng Qian, Gong Xin, Zhang Xiao-Ju, Hao Yue
5. ANALYSIS OF INNER-SCALE EFFECT ON ATMOSPHERE SCINTILLATION FOR INFRARED LASER BEAM PROPAGATING ON EARTH-SPACE PATHS
International Journal of Infrared and Millimeter Waves. Vol. 26, No. 3, pp: 467-481, 2005. Yang Rui-ke, Sun Xiu-hong, Wu Zhen-sen, Hao Yue, Wu Jian
6. 深亚微米P+栅PMOSFET中NBTI效应及氮在其中的作用
半导体学报. Vol.25, No.1, pp:84-87,2005. 韩晓亮, 郝跃, 刘红侠
7. 基于干/湿法腐蚀的自对准SiGe HBT器件的研究
半导体学报. Vol.25, No.1, pp:102-105, 2005. 刘道广, 郝跃, 徐世六, 李开成, 李培咸, 张晓菊, 张金凤, 郑雪峰, 张静, 刘嵘侃, 刘伦才
8. 0.1微米槽栅CMOS器件与相关特性研究
半导体学报. Vol.25, No.3, pp:532-535, 2005. 张晓菊, 马晓华, 任红霞, 郝跃, 孙宝刚
9. 基于MIBE的fmax="157GHz" SiGe HBT器件
半导体学报. Vol.25No.3, pp:528-531, 2005. 刘道广, 郝跃, 徐世六, 李开成, 张静, 刘嵘侃, 刘伦才
10. 考虑缺陷形状分布的IC成品率模型
半导体学报. Vol.25, No.5, pp:1054-1058, 2005. 王俊平, 郝跃
11. pMOS器件的热载流子注入和负偏压温度耦合效应
半导体学报. Vol.25, No.5, pp:1005-1009, 2005. 刘红侠, 郝跃
12. IC参数成品率全局优化的影射距离最小化算法
半导体学报. Vol.25, No.6, pp:1259 -1263, 2005. 荆明娥, 李康, 王俊平, 郝跃
13. 超深亚微米LDD nMOSFET中的非幸运电子模型效应
半导体学报. Vol.25, No.7, pp:1390-1395, 2005. 杨林安, 于春利, 郝跃
14. Yield Modeling of Rectangular Defect Outline
半导体学报. Vol.25, No.8, pp:1514-1518, 2005. Wang Jun-ping, Hao Yue
15. AlGaN基PIN光电探测器的模型与模拟

[1] [2] [3]

友情链接

西安电子科技大学微电子学院 中科院半导体所 中科院微电子所 北京大学微电子学系 清华大学信息科学技术学院 中科院上海微系统与信息所 西安中为光电科技公司

本网站版权*西安电子科技大学宽带隙半导体国家重点实验室 技术支持 * 通元动力软件 陕ICP备06007346号 电话：029-88202073
电子邮件：pjma@xidian.edu.cn